# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS



# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

IPN

PTO/SB/21 (08-03)
Approved for use through 08/30/2003. OMB 0651-0031
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number. Application Number 10/709,471 **TRANSMITTAL** Filing Date 05/07/2004 **FORM** First Named Inventor Irene Chen Art Unit (to be used for all correspondence after initial filing) Examiner Name Attorney Docket Number UTEP0012USA Total Number of Pages in This Submission

		1 agos III Tillo Cabilliosion				
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ENCLOSURES (Check all that apply)			
1	Fee Trans	smittal Form	Drawing(s)  After Allowance communication to Technology Center (TC)			
	Fee Attached  Amendment/Reply  After Final  Affidavits/declaration(s)  Extension of Time Request  Express Abandonment Request  Information Disclosure Statement		Licensing-related Papers  Petition Petition to Convert to a Provisional Application Change of Correspondence Address Terminal Disclaimer Request for Refund CD, Number of CD(s)  Appeal Communication to Board of Appeals and Interferences Appeal Communication to TC (Appeal Notice, Brief, Reply Brief) Proprietary Information Status Letter Other Enclosure(s) (please Identify below):			
		SIGNA	TURE OF APPLICANT, ATTORNEY, OR AGENT			
Firm or Individ	Firm Winston Hsu, Reg. No.: 41 526		No.: 41,526			
Signat	Signature		Juston Hay			
Date 5		٢	110/2004			
	CERTIFICATE OF TRANSMISSION/MAILING					
I hereby certify that this correspondence is being facsimile transmitted to the USPTO or deposited with the United States Postal Service with sufficient postage as first class mail in an envelope addressed to: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450 on the date shown below.						

This collection of information is required by 37 CFR 1.5. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to 12 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

Date

Typed or printed name

Signature

If you need assistance in completing the form, call 1-800-PTO-9199 and select option 2.

Name (Print/Type)

Signature

Winston Hsu

PTO/SB/17 (10-03)
Approved for use through 07/31/2006. OMB 0651-0032
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE vork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

FEE TO ANO	BAITTAI	Co	omplete if Known	
FEE IRANS	WIIIIAL	Application Number	10/709,471	
for EV 2	004	Filing Date	05/07/2004	
FEE TRANSMITTAL  for FY 2004  Effective 10/01/2003. Patent fees are subject to annual revision.  Applicant claims small entity status. See 37 CFR 1.27	First Named Inventor	Irene Chen		
		Examiner Name		
Applicant claims small entity status. S	See 37 CFR 1.27	Art Unit		
TOTAL AMOUNT OF PAYMENT	(\$) 0.00	Attemory Dealest No.	LITEP0012LISA	

TOTAL AMOUNT OF PAYMENT (\$) 0.00					Attom	ey Doo	cket N	lo.	UTEP0012USA	
METHOD OF PAYMENT (check all that apply)							FEE	CA	ALCULATION (continued)	
Check Credit card Money Other None						ONAL		S		
Denosit	Account:	- Oluei		<u>Large E</u>		Small				
Deposit				Fee Code			Fee (\$)		Fee Description	ee Paid
Account Number	50-3105			1051	130	2051		Surch	harge - late filing fee or oath	COFAIG
Deposit Account	North America Int	ellectual Pro	perty Corp.	1052	50	2052	25		harge - late provisional filing fee or or sheet	
Name The Director is authorized to: (check all that apply)			1053	130	1053	130		English specification		
The Director is authorized to: (check all that apply)  Charge fee(s) indicated below  Credit any overpayments			1812	2,520	1812 2	2,520	For fi	iling a request for ex parte reexamination		
	y additional fee(s) or a	لسا		1804	920*	1804	920*		uesting publication of SIR prior to niner action	
· ·	(s) indicated below, e	•	filing fee	1805	1,840*	1805	1,840*		uesting publication of SIR after	
to the above-id	lentified deposit accou	unt.		4054	446	2054			miner action	
	FEE CALC	ULATION		1251	110	2251	55		ension for reply within first month ension for reply within second month	
1. BASIC F	-			1252	420	2252	210			
	Small Entity  Fee Fee Fee D	escription	Fee Paid	1253 1254	950	2253 2254			ension for reply within third month	
	Code (\$)	- CONTINUE	. 55 . 414				740		ension for reply within fourth month	
1001 770	2001 385 Utili	ty filing fee		1255	•	2255			ension for reply within fifth month	
1002 340		ign filing fee		1401	330	2401			ice of Appeal	
1003 530		nt filing fee		1402	330	2402			ng a brief in support of an appeal	
1004 770		ssue filing fee		1403	290	2403			uest for oral hearing	
1005 160	2005 80 Prov	visional filing fe	e	1451		1451			tion to institute a public use proceeding	
	SUBTO	OTAL (1) (	\$) 0.00	1452	110	2452			tion to revive - unavoidable	
2. EXTRA CLAIM FEES FOR UTILITY AND REISSUE					1,330	2453			ition to revive - unintentional	
Fee from Extra Claims below Fee Paid				1501		2501			ty issue fee (or reissue)	
Total Claims	-20** = [	X	selow ree Paid	1502	480	2502			ign issue fee	
Independent	-3** =	╡ѷू	=={ }===={	1503	640	2503			nt issue fee	
Claims Multiple Depe		╜╚		1460	130	1460			itions to the Commissioner	
		<b>L</b>	L	1807	50	1807			cessing fee under 37 CFR 1.17(q)	
Fee Fee		Fee Description	on .	1806	180	1806			mission of Information Disclosure Stmt	
Code (\$)	Code (\$)	-	_	8021	40	8021	40	prop	ording each patent assignment per perty (times number of properties)	
1202 18 1201 86		aims in excess ependent clain	of 20 ns in excess of 3	1809	770	2809	385	Filin	ng a submission after final rejection CFR 1.129(a))	
1203 290		•	nt claim, if not paid	1810	770	2810	385	For	each additional invention to be	
1204 86		Reissue indepe over original pa		1801	770	2801	385		mined (37 CFR 1.129(b)) quest for Continued Examination (RCE)	
1205 18	2205 9 ** F	• •	in excess of 20	1802	900	1802	900	) Re	equest for expedited examination	
			0.00	Other	fee (sp	ecifv)		J. 0	assign approximan	
**or numbo	SUBTOT		(\$) 0.00		٠.	Basic F	Filing F	ee Pa	aid SUBTOTAL (3) (\$) 0.00	
	r previously paid, if gr	eater; For Reis	ssues, see above							
SUBMITTED	BY								(Complete (if applicable))	

6 WARNING: Information on this form may become public. Credit card information should not be included on this form. Provide credit card information and authorization on PTO-2038.

This collection of information is required by 37 CFR 1.17 and 1.27. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 12 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

Registration No.

(Attorney/Agent)

41,526

Telephone 886289237350

Date

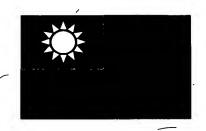


PTO/SB/02B (11-00)
Approved for use through 10/31/2002. OMB 0651-0032
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

# **DECLARATION** — Supplemental Priority Data Sheet

Additional foreign app	Additional foreign applications:						
Prior Foreign Application Number(s)	Country	Foreign Filing Date (MM/DD/YYYY)	Priority Not Claimed	Certified Copy Attached? YES NO			
093102049	Taiwan R.O.C	01/29/2004					
·							

Burden Hour Statement: This form is estimated to take 21 minutes to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Assistant Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.



# 되면 되면 되면 되면



# 中華民國經濟部智慧財產局

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS REPUBLIC OF CHINA

兹證明所附文件,係本局存檔中原申請案的副本,正確無訛

其申請資料如下

This is to certify that annexed is a true copy from the records of this office of the application as originally filed which is identified hereunder:

2004 年 01

Application Date

093102049

Application No.

鈺德科技股份有限公司

Applicant(s)

局

Director General

西元 \_\_\_\_ 2004 年

Issue Date

發文字號: Serial No.

09320368760

申請日期:	IPC分類
申請案號:	

中文       製作具微結構圖案之壓模板的方法         中文       METHOD OF FABRICATING A STAMPER WITH MICROSTRUCTURE PATTERNS         英明名稱       女名(中文)         处名(中文)       1. 陳怡礽         世名(英文)       1. CHEN, IRENE         (英日人)       (典義文)         1. 中華民國 TW	
發明名稱     英文       姓名(中文)     红名(中文)       姓名(英文)     1. CHEN, IRENE       증明人     國籍       1. 中華民國 TW	
(中文)         姓名(英文)         1. CHEN, IRENE         会明人         國籍         1. 中華民國 TW	
会明人 図籍 1. 中華民國 TW	
住居所 (中 文)	
住居所 1. No. 222, Hwa-Ya II Rd., Kuei-Shan Hsiang, Tao-Yuan Hsien 333, Taiwan, R.O.C.	
名稱或 1. 鈺德科技股份有限公司 姓 名 (中文)	
名稱或 1. U-TECH MEDIA CORP. 姓 名 (英文)	
三 図籍 (中英文) 1. 中華民國 TW	
申請人 住居所 1. 桃園縣龜山鄉華亞二路二二二號 (本地址與前向貴局申請者相同) (營業所) (中 文)	
住居所 1. No. 222, Hwa-Ya II Rd., Kuei-Shan Hsiang, Tao-Yuan Hsien 333, (營業所) (英文)	
代表人(中文)	
代表人 (英文)	



申請日期:	IPC分類
申請案號:	

(以上各欄	(以上各欄由本局填註) 發明專利說明書					
_	中文					
發明名稱	英 文					
	姓 名(中文)	2. 周天佑				
÷	姓 名 (英文)	2. CHOU, TIEN-YU				
發明人 (共6人)	國 籍 (中英文)	2. 中華民國 TW				
	住居所(中 文)	2. 桃園縣龜山鄉華亞二路二二二號				
	住居所(英文)	2.No. 222, Hwa-Ya II Rd., Kuei-Shan Hsiang, Tao-Yuan Hsien 333, Taiwan, R.O.C.				
	名稱或 姓 名 (中文)					
	名稱或 姓 名 (英文)					
Ξ	國籍(中英文)					
申請人(共1人)	住居所 (營業所) (中 文)					
	住居所 (營業所) (英 文)					
	代表人(中文)					
	代表人 (英文)					



申請日期:	IPC分類
申請案號:	

(以上各欄)	以上各欄由本局填註) 發明專利說明書				
_	中文				
發明名稱	英文				
	姓 名(中文)	3. 賴志輝			
=	姓 名 (英文)	3. LAY, JYH-HUEI			
發明人 (共6人)	國 籍 (中英文)	3. 中華民國 TW			
(340)()	住居所(中文)	3. 桃園縣龜山鄉華亞二路二二二號			
	住居所 (英文)	3.No. 222, Hwa-Ya II Rd., Kuei-Shan Hsiang, Tao-Yuan Hsien 333, Taiwan, R.O.C.			
	名稱或 姓 名 (中文)				
三 申請人 (共1人)	名稱或 姓 名 (英文)				
	國 籍 (中英文)				
	住居所 (營業所) (中 文)				
	住居所 (營業所) (英 文)				
	代表人(中文)				
	代表人(英文)				



申請日期:	IPC分類	
申請案號:		

(以上各欄由本局填註) 發明專利說明書				
	中文			
發明名稱	英文			
	姓 名(中文)	4. 陳怡發		
÷	姓 名 (英文)	4. CHEN, YIH-FAR		
發明人(共6人)	國 籍 (中英文)	4. 中華民國 TW		
(3,0)()	住居所(中文)	4. 桃園縣龜山鄉華亞二路二二號		
	住居所 (英文)	4.No. 222, Hwa-Ya II Rd., Kuei-Shan Hsiang, Tao-Yuan Hsien 333, Taiwan, R.O.C.		
	名稱或 姓 名 (中文)			
= .	名稱或 姓 名 (英文)			
	國 籍 (中英文)			
申請人(共1人)	住居所 (營業所) (中 文)			
	住居所 (營業所) (英 文)			
	代表人(中文)			
	代表人(英文)			



申請日期:	IPC分類	
申請案號:		

(以上各欄由本局填註) 發明專利說明書			
_	中文		
發明名稱	英文		
	姓 名(中文)	5. 張世慧	
-	姓 名 (英文)	5. ZHANG, SHI-HUI	
發明人 (共6人)	國籍(中英文)	5. 中華民國 TW	
(3,0,0)	住居所(中文)	5. 桃園縣龜山鄉華亞二路二二號	
	住居所 (英文)	5. No. 222, Hwa-Ya II Rd., Kuei-Shan Hsiang, Tao-Yuan Hsien 333, Taiwan, R.O.C.	
	名稱或 姓 名 (中文)		
	名稱或 姓 名 (英文)		
=	國 籍 (中英文)	·	
申請人(共1人)	住居所 (營業所) (中 文)		
	住居所 (營業所) (英 文)		
	代表人 (中文)		
	代表人 (英文)		



申請日期:	IPC分類	
申請案號:  (以上各欄由	<sup>]本局填註)</sup> 發明專利說明書	./
	中文	
一 、 發明名稱	英 文	
4.7	姓 名 6. 王元宏 (中文)	
_	姓名 (英文)	
二 發明人 (共6人)	國籍 (中英文) 6. 中華民國 TW (中英文) 6. 桃園縣龜山鄉華亞二路二二號	_
	(中文) 16 No. 222 Hwa-Ya II Rd., Kuei-Shan Hsiang, Tao-Yuan Hsien 333,	-
	住居所 (英 文) Taiwan, R. O. C.	_
	姓 名 (中文) 名稱或	_
三	姓 名   (英文)     國 籍	
申請人 (共1人)	住居所、	
	住居所 (營業所) (英 文)	
	代表人(中文)	
	代表人 (英文)	_

#### 四、中文發明摘要 (發明名稱:製作具微結構圖案之壓模板的方法)

本發明提供一種製作具有微結構圖案之壓模板的方法。該方法係先提供一基板,然後於基板上形成一與該微結構圖案相反之第一圖案層,然後於基板上形成一第二圖案層,用以定義出壓模板之尺寸邊緣,最後再進行一電鑄製程,並利用第二圖案層作為一電鑄生長圍牆,以於基板上形成至少一該壓模板。

五、英文發明摘要 (發明名稱:METHOD OF FABRICATING A STAMPER WITH MICROSTRUCTURE PATTERNS)

A method of fabricating a stamper with microstructure patterns is provided. The method includes providing a substrate, forming a first patterned layer on the substrate, forming a second patterned layer on the substrate for defining the rim of the stamper, and performing a electroforming process by taking the second pattern layer as a growth stop layer so as to



四、中文發明摘要	(發明名稱:製作具微結構圖案之壓模板的方法)
五、英文發明摘要	(發明名稱: METHOD OF FABRICATING A STAMPER WITH MICROSTRUCTURE
PATTERNS)	
from the s	tamper.
MIII KANTAKANAN MUKANAN BULANAN	NIA-WAZ III III

## 六、指定代表圖

- (一)、本案代表圖為:第\_\_\_ 六\_\_\_ 圖
- (二)、本案代表圖之元件代表符號簡單說明:

10 基板

12' 第一圖案層 16 第二圖案層

14 電鑄晶種層

18a、18b 壓模板



一、本案已向			
國家(地區)申請專利	申請日期	案號	主張專利法第二十四條第一項優先權
		無	
		7111	·
二、□主張專利法第二十五	L條之一第一項係	憂先權:	•
申請案號:		<b>L</b>	
日期:		無	
	<b>上第二十條第一</b> I	頁□第一款但書:	或□第二款但書規定之期間
	1 / / / · · · · ·	<u> </u>	
日期:			
四、□有關微生物已寄存方	仒國外:		
寄存國家:		無	
寄存機構:		<del>7111</del>	
寄存日期: 寄存號碼:			
□有關微生物已寄存 <sup>力</sup>	於國內(本局所指	定之寄存機構)	:
寄存機構:			
寄存日期:		無	
寄存號碼:			
□熟習該項技術者易力	於獲得, 不須寄存	<u>.</u> •	
	•		

## 五、發明說明 (1)

# 【發明所屬之技術領域】

本發明提供一種製作壓模板(stamper)的方法,尤指一種製作免切割式壓模板的方法。

# 【先前技術】





#### 五、發明說明 (2)

### 【發明內容】

因此本發明之主要目的在於提供一種在電鑄製程中利用生長圍牆製作出壓模板的方法,以解決習知製作壓模板方法的問題。

本發明之申請專利範圍係揭露一種製作具有微結構圖案之壓模板的方法係先提供一基板,接著於基板上形成一節一個案層之圖案層之圖案層之圖案層之一個案層,用來定義出壓模板之尺寸邊緣,最後再進行一電鑄製程,並利用第二圖案層作為電鑄生長圍牆,於基板上形成至少一該壓模板。





#### 五、發明說明 (3)

由於本發明係在電鑄製程之前,先於基板上形成作為電鑄生長圍牆的第二圖案層,以使電鑄製成的壓模板具有符合射出成型模具之尺寸,因此在形成壓模板之後,便不需另外再進行機械加工的切割程序,故可有效避免因傳統機械加工所造成之變形及毛邊等問題。

# 【實施方法】

請參考圖三,接著於基板10以及第一圖案層12、表面形成一層較薄的電鑄晶種層(seed layer) 14,並階梯覆蓋(step cover)於第一圖案層12、以及基板10表面,以使電鑄晶種層14呈現與第一圖案層12、相同之圖案。其中,電





#### 五、發明說明(4)

鑄晶種層14之主要作用是在電鑄製程中幫助電鑄金屬物附著及長晶,因此,電鑄晶種層14之厚度係依製程需要而定,厚度單位可小至奈米(nanometer, nm)等級,而為達到電鑄晶種層14之功能,其材料為可導電之金屬材料較佳,例如鎳、銀等材料,並可以濺鍍、蒸鍍或無電鍍等方式形成。此外,具導電性之碳膜等非金屬材料亦可作為電鑄晶種層14。

請參考圖五,圖五為圖四中所示之基板10、第二圖案層16以及電鑄晶種層14的上視圖。由於第一圖案層12,是用來定義壓模板表面之微結構圖案,而第二圖案層16是用來定義壓模板之尺寸邊緣,因此兩者的圖案在基板10表面係呈錯開分佈,不會重疊。亦即如圖五所示,部分之





#### 五、發明說明 (5)

電鑄晶種層14覆蓋於凸起之第一圖案層12、表面,而第二圖案層16則分佈於第一圖案層12、外圍。

然後,請參考圖六,進行一電鑄製程,使金屬材料沿著電鑄晶種層14表面生長,但卻不附著於絕緣的第二圖案層16表面,以於基板10表面形成二壓模板18a、18b。如前所述,電鑄厚度必須小於第二圖案層16之厚度,以使得第二圖案層16得以發揮生長圍牆之功能,而將壓模板18a、18b的尺寸限定在第二圖案層16所包圍之區域內。如此,製作出之壓模板18a、18b便有固定之大小,而不需要另外進行切割或加工的動作。

最後,如圖七所示,進行一脫膜製程,使壓模板18a、18b與基板10、第二圖案層16及第一圖案層12、相互分離,而得到不需經由切割的壓模板18a、18b,並直接過層於射出成型模具中當作模仁使用。此外,若電鑄晶種層14之材料和製作出之壓模板18a、18b材料相同時,個如兩者皆為金屬鎮,則不需要將壓模板18a、18b表面上的電鑄晶種層14當作模仁使用。 18a、18b連同其表面上的電鑄晶種層14當作模仁使用。 另一方面,當電鑄晶種層14與壓模板18a、18b的形成材料不同時,則在脫膜製程中,還必須將電鑄晶種層14從壓模板18a、18b表面移除。





#### 五、發明說明 (6)

請参考圖八,圖八為本發明製作壓模板方法之第三實施 例的示意圖。在本發明之第三實施例中,電鑄晶種層32 係 形 成 於 基 板 3 0 以 及 第 一 圖 案 層 3 4 之 間 。 因 此 在 第 三 實 施例中,係先於基板10表面形成電鑄晶種層32,才於電 鑄 晶 種 層 3 2 表 面 形 成 第 一 圖 案 層 3 4 以 及 第 二 圖 案 層 3 6 值得注意的是,由於第一圖案層34以及第二圖 案 層 3 6 之 圖 案 不 重 疊 , 因 此 兩 者 的 形 成 順 序 可 以 對 調 , 或 是 藉 由 同一材料層所形成。例如,當第一以及第二圖案層34、 36 係 由 同 一 材 料 層 所 形 成 時 , 由 於 第 二 圖 案 層36 之 厚 度 必 須 大 於 後 續 形 成 之 壓 模 板 3 8 a 、 3 8 b , 而 第 一 圖 案 層 3 4 層 $34 \times 36$  之 材 料 可 選 擇 非 感 光 性 材 料 , 然 後 利 用 複 數 次 圖案化光阻層來分別進行數次蝕刻,以形成不同厚度的 第一以及第二圖案層34、36。另一方面,為了提高電鑄 製 程 的 效 果 , 第 一 圖 案 層 3 4 可 選 擇 性 地 以 導 電 材 料 製





#### 五、發明說明 (7)

成,以確保壓模板38a、38b表面可以形成貼合第一圖案層34之微結構圖案。

在本發明之第四實施例中,係直接使用本身為導電材料的基板,並於其上形成分別定義出微結構圖案以及壓模板邊緣尺寸的第一以及第二圖案層,然後以第二圖案層為生長圍牆,進行電鑄製程,以形成壓模板。同樣地,第一圖案層可選擇性地以導電材料製成,以提高電鑄製程之效果。

以上所述僅為本發明之較佳實施例,凡依本發明申請專利範圍所做之均等變化與修飾,皆應屬本發明專利之涵蓋範圍。





#### 圖式簡單說明

## 圖式之簡單說明

圖一至圖七為本發明製作壓模板方法之第一實施例的製程示意圖。

圖八為本發明製作壓模板方法之第三實施例的示意圖。

## 圖式之符號說明

1 0	基 板	
12'	第一圖	案 層
16	第二圖	案 層
3 0	基 板	
3 4	第一圖	案 層
38a	38b	壓 模 板

12	光阻層	
14	電鑄晶	種 層
18a	· 18b	壓模板
3 2	電鑄晶	種 層
3 6	第二圖	案 層



# 六、申請專利範圍

1. 一種製作具有微結構圖案之壓模板(stamper)的方法,該方法包含有下列步驟:

提供一基板;

於該基板上形成一第一圖案層,且該第一圖案層之圖案係與該微結構圖案相反;

於該基板上形成一第二圖案層,且該第二圖案層係用來定義出該壓模板之尺寸邊緣;以及

進行一電鑄製程,並利用該第二圖案層作為一電鑄生長圍牆,以於該基板上形成至少一該壓模板。

- 2. 如申請專利範圍第1項之方法,其中該方法另包含有形成一電鑄晶種層(seed layer)的步驟。
- 3. 如申請專利範圍第2項之方法,其中該電鑄晶種層係形成於該基板表面並階梯覆蓋(step cover)於該第一光阻層之上,以使該電鑄晶種層呈現與該第一圖案層相同之圖案。
- 4. 如申請專利範圍第2項之方法,其中該電鑄晶種層係形成於該基板以及該第一光阻層之間。
- 5. 如申請專利範圍第2項之方法,其中該電鑄晶種層係為一金屬層。



#### 六、申請專利範圍

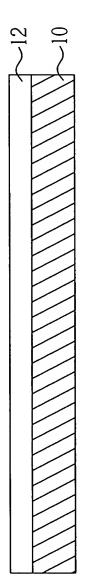
- 6. 如申請專利範圍第1項之方法,其中該基板可由導電材料所構成。
- 7. 如申請專利範圍第1項之方法,其中該第二圖案層不與該第一圖案層相重疊。
- 8. 如申請專利範圍第1項之方法,其中該第二圖案層之厚度大於該壓模板之厚度。
- 9. 如申請專利範圍第1項之方法,其中該第一圖案層係由一感光材料所構成。
- 10.如申請專利範圍第9項之方法,其中該第一圖案層為正型光阻材料或負型光阻材料。
- 11. 如申請專利範圍第1項之方法,其中該第二圖案層係由一感光材料所構成。
- 12. 如申請專利範圍第11項之方法,其中該第二圖案層為正型光阻材料或負型光阻材料。
- 13. 如申請專利範圍第1項之方法,其中該第一圖案層係由一導電材料所構成。



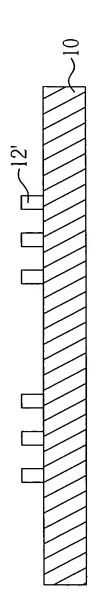
# 六、申請專利範圍

- 14. 如申請專利範圍第1項之方法,其中該第二圖案層係由一絕緣材料所構成。
- 15. 如申請專利範圍第1項之方法,其中該方法另包含有一使該壓模板與該基板分離的步驟,以得到一完整而不需切割之該壓模板。

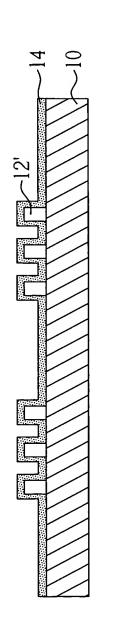




圃

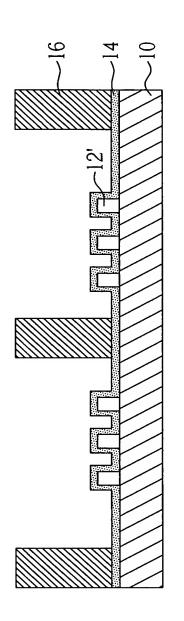


画

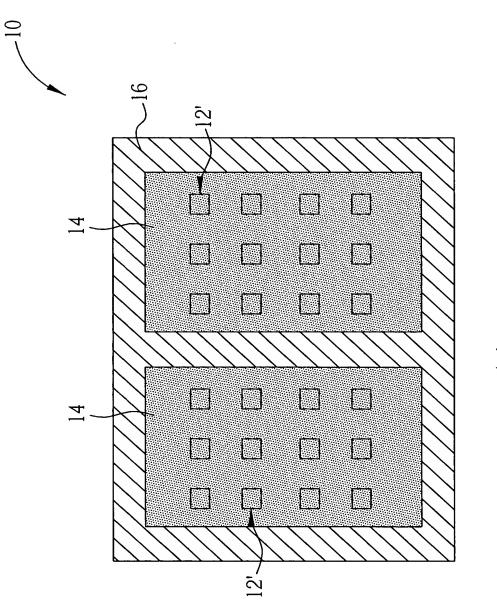


画

.



圖四

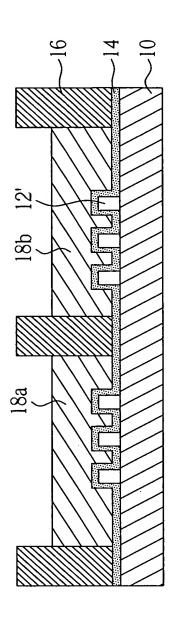


圖五

-

•

-



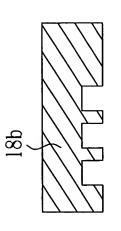
圖

-

.

--1





圖十

.

.

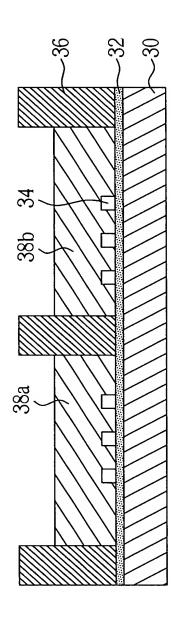


图)

•

• •

